

文部科学省委託事業【マテリアル先端リサーチインフラ】
大阪大学マテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点

令和4年度支援利用申請書【学内・ARIM微細加工/ARIM物質合成プラットフォーム用】

令和 年 月 日

大阪大学マテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点長 殿

支援利用申請者

氏 名：
フリガナ：
職 名：
所 属：大阪大学
所 在 地：〒 —

TEL : — —

E-mail :

年齢区分： 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代以上

指導教官（申請者が学生/院生の場合）

氏 名：
フリガナ：
職 名：
所 属：大阪大学

下記のとおりマテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点を利用したいので申請します。

記

1. 申請課題名

和文：

Eng.:

2. 支援利用での希望

支援利用による成果： 公開（成果公開事業） 非公開（成果非公開事業）

3. 希望する支援利用形態（申請時は複数選択可）

- (1) 機器利用
- (2) 技術代行
- (3) 技術補助
- (4) 協力研究/共同利用
- (5) 技術相談

4. 利用の期間（年度内）

令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日

5. 利用したい装置【ARIM 微細加工プラットフォーム・ARIM 物質合成プラットフォーム支援提供装置】

レ 印	装置 番号	ARIM 装置番号	設備(設備群)名	メーカー・機種	CR
	F11	OS-101	高精細集束イオンビーム装置 (He/Ne イオン)	ZEISS “ORION NanoFab”	
	I21	OS-114	金属成膜用 RF スパッタ装置	サンヨー電子 “SVC-700LRF”	
	I22	OS-115	絶縁膜成膜用 RF スパッタ装置	サンヨー電子 “SVC-700LRF”	
	I23	OS-110	反応性イオンエッチング装置	サムコ “RIE-10NR-NP”	
	I24	OS-109	深掘りエッチング装置	サムコ “RIE-400iPB-NP”	
	I25	OS-103	超高精細電子ビームリソグラフィー装置125k	エリオニクス “ELS-100T”	
	N01	OS-102	SEM 付集束イオンビーム装置	ZEISS “Nvision 40D with NPVE”	
	N02	OS-111	反応性イオンエッチング装置	サムコ “RIE-10NOU”	
	N03	OS-113	多元 DC/RF スパッタ装置	キヤノンアネルバ “EB1100”	
	N04	OS-116	ICP-RF スパッタ装置(ヘリコン型 RF スパッタ装置)	アルバック “MB02-5002”	
	N05	OS-117	EB 蒸着装置	アルバック “UEP-2000 OT-H/C”	
	N06	OS-112	電気炉	誠南工業 “ARF-30K”	
	N07	OS-126	接触式膜厚測定器(膜厚計)	BRUKER “DektakXT-A”	
	N08	OS-107	マスクアライナー	ミカサ “MA-10”	
	N09	OS-105	高速大面積電子ビームリソグラフィー装置	エリオニクス “ELS-S50LBC”	
	N10	OS-104	超高精細電子ビームリソグラフィー装置150k (装置調整中、供用開始時期は別途案内します)	エリオニクス “ELS-BODEN-OU4801”	
	N31	OS-127	レーザーラマン顕微鏡	ナノフoton “RAMAN-touch VIS-NIR-OUN”	
	N32	OS-125	走査型プローブ顕微鏡(E-sweep)	日立ハイテクサイエンス “AFM5000/AFM5300E”	
	S01	OS-108	ナノインプリント装置	Obducat “Eitre 3”	
	S31	OS-106	LED 描画装置	ピーエムティー “PLS-1010”	
	S32	OS-120	薄膜 X 線回折装置	リガク “Ultima IV”	
	S33	OS-121	テラヘルツ分光装置	日邦プレジジョン “Pulse IRS 2000-os”	
	S34	OS-122	フーリエ変換赤外分光光度計	日本分光 “6100FV MCT-600”	
	S35	OS-123	ナノ粒子解析装置(ゼーターサイザー)	シスメックス “NANO-ZS”	
	S36	OS-124	位相変調型分光エリプソメーター	堀場製作所 “UVISEL LT NIR-NNG”	
	N61	OS-118	パルスレーザーMBE 装置(PLD)	誠南工業 “PLO-020R”	
	N62	OS-119	自動制御型パルスレーザー蒸着ナノマテリアル合成装置	パスカル “MC-LMBE”	

CR 欄に もしくは がある装置はクリーンルーム内に設置されています。入室時にクリーンルーム入室料が別途加算されます。提出後の利用したい装置の追加は可能です(本ページのみの再提出で可)。

【付帯装置の課金について】

以下の装置については利用したい装置としての申請は不要ですが、課金対象装置になります。ご利用の際はご注意ください。

装置 番号	設備(設備群)名	メーカー	CR
N71	タングステンコーター	エリオニクス	
N72	プラズマクリーナー	日本電子	
N73,I73	スピコーター	ミカサ	○
N74	UV オゾンクリーナー		

支援利用負担金

機器利用料（消費税込み、ARIM 微細加工プラットフォーム、ARIM 分子・物質合成プラットフォーム）

No.	装置名	成果公開		成果非公開		備考
		大学・公的研究機関	民間企業等	大学・公的研究機関	民間企業等	
		円/時間	円/時間	円/時間	円/時間	
F11	高精細集束イオンビーム装置	5,100	7,650	15,300	22,950	
I21	RF スパッタ成膜装置（金属成膜用）	4,900	7,350	14,700	22,050	Au, Pt は別途請求
I22	RF スパッタ成膜装置（絶縁体成膜用）	4,700	7,050	14,100	21,150	Au, Pt は別途請求
I23	リアクティブイオンエッチング装置（RIE-10NR-NP）	5,900	8,850	17,700	26,550	
I24	深掘りエッチング装置	13,100	19,650	39,300	58,950	
I25	超高精細電子ビームリソグラフィ装置	5,700	8,550	17,100	25,650	
N01	SEM 付集束イオンビーム装置	7,100	10,650	21,300	31,950	
N02	リアクティブイオンエッチング装置（RIE-10NOU）	5,100	7,650	15,300	22,950	
N03	多元 DC/RF スパッタ装置	4,400	6,600	13,200	19,800	Au, Pt は別途請求
N04	誘導結合型 RF プラズマ支援スパッタ装置（ICP-RF スパッタ装置）	3,400	5,100	10,200	15,300	
N05	EB 蒸着装置	3,900	5,850	11,700	17,550	Au, Pt は別途請求
N06	高温熱処理装置（セラミックス電気管状炉）	3,600	5,400	10,800	16,200	
N07	接触式膜厚測定器	3,500	5,250	10,500	15,750	
N08	マスクアライナー	3,400	5,100	10,200	15,300	
N09	高速大面積電子ビームリソグラフィ装置	6,600	9,900	19,800	29,700	
N31	レーザーラマン顕微鏡	1,900	2,850	5,700	8,550	
N32	走査型プローブ顕微鏡	1,700	2,550	5,100	7,650	
N61	パルスレーザー-MBE 装置（PLD）	2,700	4,050	8,100	12,150	
N71	タングステンコーター	550	825	1,650	2,475	
N72	プラズマクリーナー	550	825	1,650	2,475	
N73	スピンコーター	550	825	1,650	2,475	
N74	UV オゾンクリーナー	550	825	1,650	2,475	
S01	ナノインプリント装置	4,900	7,350	14,700	22,050	

S31	LED 描画システム	2,400	3,600	7,200	10,800	
S32	薄膜 X 線回折装置	3,400	5,100	10,200	15,300	
S33	フーリエ変換赤外分光光度計	1,200	1,800	3,600	5,400	
S34	赤外・テラヘルツ時間分解分光装置	3,600	5,400	10,800	16,200	
S35	ナノ粒子解析装置 (ゼーターサイザー)	2,600	3,900	7,800	11,700	
S36	位相変調型分光エリプソメーター	1,900	2,850	5,700	8,550	

- ・利用時間とは装置予約時間（使用の有無は問わない）を指し、予約時間前後に延長利用した場合はその時間も含む（ただし予約無しで利用できる装置(N07、N71～N74)は、実使用時間を利用時間とする）
- ・上記は 1 時間あたりの単価であり、これに利用時間に乗じた額を機器利用料とする
- ・装置予約の取り消しは予約日の 1 営業日前の 17 時に締め切り、それ以降の取り消しについては当該予約の 100%に相当する額を徴収する
- ・1 時間未満の端数は切り上げ、1 時間として算出する

技術支援料（消費税込み、ARIM 微細加工プラットフォーム、ARIM 分子・物質合成プラットフォーム）

支援内容	成果公開		成果非公開	
	大学・公的研究機関	民間企業等	大学・公的研究機関	民間企業等
	円 / 時間	円 / 時間	円 / 時間	円 / 時間
技術代行	4,000	6,000		
技術補助、オペレーショントレーニング	1,000	1,500	3,000	4,500

- ・上記は 1 時間あたりの単価であり、これに利用時間に乗じた額を技術支援料とする
- ・1 時間未満の端数は切り上げ、1 時間として算出する

クリーンルーム入室料（消費税込み、所属区分や成果公開区分によらず同額）

課金対象となる部屋	円 / 日・人	備考
I215 室	500	上限 5,000 円 / 月
N415 室	500	上限 5,000 円 / 月

- ・同時に複数にわたる課題で利用する場合には、拠点長が指定する課題に対して課す

成膜用材料、レジスト等一部の消耗品は実費負担とする
消耗品費の額については、拠点長が別途告示する

7. 本申請課題に関連した助成金・競争的資金

本申請課題に関連した助成金や競争的資金を得ている場合、その資金名および課題名(該当なき場合は「なし」と記入)

資金名: _____ (例:「科研費(基盤 A)」、「(公財) 振興会 スタートアップ研究助成」、「A-STEP 育成事業」)

課題名(任意): _____

(利用負担金の実際の支払い財源の問い合わせではありません。助成金や競争的資金の申請課題を実施するあたり、研究・開発計画の一部について当拠点を利用して進める場合にご記入ください。利用負担金の実際の支払い財源については本申請書の6ページ目にご記入ください(大阪大学内の利用者。))

8. 経理担当者(研究室内の会計担当者など)

(すべての項目を正確に記入してください)

氏名:

フリガナ:

職名:

所属名:

所在地: 〒 _____

TEL: _____

E-mail: _____

9. 当拠点を利用するきっかけ(新規申請の方のみ 任意記入)

大阪大学マテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点 支援利用負担金支払計画書

【対象者:学内経費で支払い予定の方】

各部署の経理担当と相談の上、下記の例に従って利用料金の支払い計画を提出してください。期間で財源を分ける場合は、その旨備考欄に記入してください。ここに書かれている財源のいかにかわらず、利用明細発行時に改めて支払い財源を照会します(変更可能)。希望する財源が支援利用負担金の支払いに充当可能かどうかの確認は利用者自身で行ってください。

【支援利用申請者の氏名_____】

所属 部局名	研究 代表者名	期間	支払財源	所管名 プロジェクト名	所管コード プロジェクトコード	備考
工学研究科 (記入例)	** 助教	R3/4 月 ~ R4/3 月 (通年)	科研費若手 A (補助金)		A12345678	
産業科学研究所 (記入例)	** 教授	R3/4 月 ~ R3/6 月 (3 カ月) R3/7 月 ~ R4/3 月 (9 カ月)	運営費交付金 受託研究費(JST)		1234567890 J123456789	